

XDCR 名称	XDCR S/N	部分	浸泡前	浸泡后	差异（之前之后）	后果	
14L5SP	21080039	抗电强度		0.142毫安	0.172mA	-	通过
		泄漏试验		8.759 uA	9.874uA	-	通过
		探查 要素 测验	Sens. std 8.5兆赫	0.45分贝	0.59分贝	0.14分贝	通过
			Sens. std 频率为10.5MHz	0.56分贝	0.73分贝	0.17分贝	通过
			Sens. std 在6.0MHz	0.46分贝	0.51分贝	0.05分贝	通过
			TOF	7.01纳秒	3.77纳秒	3.24纳秒	通过
			死去的 要素	0	0	0	通过
		外观检查		无缺陷	无缺陷	-	通过

XDCR 名称	XDCR S/N	部分		浸泡前	浸泡后	差异（之前之后）	后果
10MC3	20060694	抗电强度		0.227毫安	0.208毫安	-	通过
		泄漏试验		14.126 uA	13.775uA	-	通过
		探查 要素 测验	Sens. std 6.5兆赫	0.4分贝	0.59分贝	0.19分贝	通过
			Sens. std 5.0兆赫	0.4分贝	0.7分贝	0.3分贝	通过
			Sens. std 8.0兆赫	0.68分贝	1.34分贝	0.66分贝	通过
			TOF	6.4纳秒	8.77纳秒	2.37纳秒	通过
			死去的 要素	0	0	0	通过
		外观检查		无缺陷	无缺陷	-	通过

XDCR 名称	XDCR S/N	部分		浸泡前	浸泡后	差异（之前之后）	后果
EC9-4	20220122	抗电强度		0.233毫安	0.222毫安	-	通过
		泄漏试验		14.420 uA	14.013uA	-	通过
		探查 要素 测验	Sens. std 6.5兆赫	0.73分贝	0.49分贝	0.24分贝	通过
			Sens. std 在4.0MHz	0.66分贝	0.54分贝	0.12分贝	通过
			Sens. std 在8.0MHz	0.9分贝	0.59分贝	0.31dB	通过
			TOF	5.87纳秒	5.43纳秒	0.44纳秒	通过
			死去的 要素	0	0	0	通过
		外观检查		无缺陷	无缺陷	-	通过

XDCR 名称	XDCR S/N	部分		浸泡前	浸泡后	差异（之前之后）	后果	
V5M	21060007	抗电强度		3.97毫安	4.96毫安		通过	
		泄漏试验		247.362uA	298.852 uA	-	通过	
		探查 要素 测验	Sens Stdev at 0 deg	7MHz	1分贝	0.8分贝	0.2分贝	通过
				在5MHz	0.97分贝	0.9分贝	0.07分贝	通过
				3.5兆赫	1.44分贝	1.2分贝	0.24分贝	通过
			TOF		3.6 nS	3.6 nS	0.0 ns	通过
			死元素		0	0	0	通过
		外观检查		无缺陷	无缺陷	-	通过	